

Dk 3.68 Df 0.0074
@13GHz

Tg(DSC) 176°C

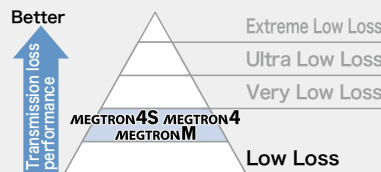
T288(含铜)
30分钟

MEGTRON4 MEGTRON4S MEGTRONM

芯板	芯板	芯板
R-5725	R-5725S	R-5735
半固化片	半固化片	半固化片
R-5620	R-5620S	R-5630

低传输损耗·高耐热性多层基板材料

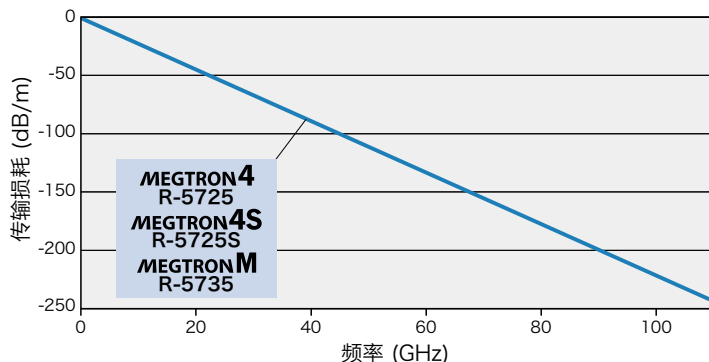
适用于高端服务器和路由等高速大容量数据传输产品



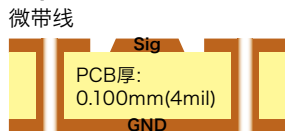
应用 网络/无线通信

ICT 基础设施设备, 超级计算机, 测量设备, 天线(基站、车载毫米波雷达)等

传输损耗比较



叠构



测定方法	2端口 S参数
测定频率	10MHz~110GHz
校正方法	TRL法
阻抗匹配	调整到 50Ω(Zo)

- 层1: 信号线层
(线宽: 270μm、铜箔厚度: 24μm)
- 层2: GND平面层
(铜箔厚度: 24μm)

高多层耐热性

结果

孔径	φ0.3mm	
通孔壁间距离	0.6mm	0.7mm
MEGTRON4	合格	合格
MEGTRON4S	合格	合格
MEGTRONM	合格	合格

条件

260°C回流焊×10次

叠构

28层
板厚: 3.8mm



一般特性

项目	试验方法	条件	单位	MEGTRON4 R-5725	MEGTRON4S R-5725S	MEGTRONM R-5735
玻璃态转化温度(Tg)	DSC	A	°C	176	200	195
热膨胀系数(Z-轴方向)	IPC-TM-650 2.4.24	A	ppm/°C	α1	35	31
				α2	265	240
T288(含铜)	IPC-TM-650 2.4.24.1	A	分钟	30	50	35
介电常数(Dk)	平衡型圆盘共振法	C-24/23/50	-	10-13GHz	3.68 [13GHz]	3.75 [13GHz]
介质损耗因数(Df)				0.0074 [13GHz]	0.0087 [13GHz]	
铜箔剥离强度	1oz(35μm)	IPC-TM-650 2.4.8	A	kN/m	1.2 [ST]	1.3 [ST]

试验片厚度为0.8mm。

* 试验方法: IPC-TM-650 2.5.5.5

在使用本产品时, 请在我公司网站上确认注意事项。

industrial.panasonic.com/ea/electronic-materials

松下电器机电 MEGTRON4 MEGTRON4S MEGTRON M

上述数据为本公司测量所得的代表值, 非保证值。

松下电器机电(中国)有限公司

© Panasonic Industry (China) Co., Ltd. 202503